

第3回先進プラズマ科学と窒化物及びナノ材料への応用に関する国際シンポジウム
ISPlasma2011プログラム(下案)

3/6 (日)	3/7 (月)	3/8 (火)	3/9 (水)						
	(9:00-)受付	(9:00-)受付	(9:00-)受付						
	開会・特別講演 座長：増田秀樹（名古屋工業大学） 【A会場】 (9:15-9:30) 開会挨拶 【来賓挨拶】常盤豊（文部科学省 高等教育局主任視学官（科学技術・学術総括官）） 【主催者挨拶】松尾稔（（財）科学技術交流財団 理事長） 【ISPlasma2011組織委員会委員長挨拶】堀勝（名古屋大学 教授） (9:30-9:40) 開会の辞（Opening Talk） 大塚 美則（（財）科学技術交流財団 東海広域知的クラスター創成事業本部 事業総括） “Tokai Region Nanotechnology Manufacturing Cluster and its Expansion Program” (9:40-10:10) 特別講演 7a-A01PL 梶 裕之（豊田工業大学） “From Superlattices to Quantum Dots: Roles of Nanostructures in Advanced Electronics and Photonics”	I 座長：F. Laermer(Robert Bosch GmbH, Germany) 【A会場】 (9:20-9:50) 基調講演 8a-A01KA M. J. Goeckner (Univ. of Texas, Dallas, USA) “An Improved Understanding of Fluorocarbon Plasmas” (9:50-10:20) 基調講演 8a-A02KA A. Wendt (Univ. of Wisconsin – Madison, USA) “Control of Bombarding Ion Energy Distributions in Plasma Processing” (10:20-10:40) 8a-A03OA (10084) K. Hirota (Hitachi, Ltd, Japan) “Study of Process Drift Caused by Ti Residue on Reactor Walls in Metal Gate Etching”	座長：徳田豊（愛知工業大学） 【B会場】 (9:20-9:50) 基調講演 8a-B01KB F. Ponce (Arizona State Univ., USA) “Polarization Effects in Group-III Nitride Semiconductor Heterostructure Devices” (9:50-10:10) 8a-B02OB (10296) Z. Chen (Nagoya Inst. of Tech., Japan) “Optical Properties and Deep Traps of InAlN Lattice-matched to GaN Grown by MOCVD” (10:10-10:30) 8a-B03OB Y. Nakano (Chubu Univ., Japan) “Correlation between Current Collapses and Deep-Level Defects in AlGaIn/GaN Hetero-Structures Probed by Photo-Capacitance Spectroscopy”	ナノ材料3 座長：川崎晋司（名古屋工業大学） 【C会場】 (9:20-9:50) 基調講演 8a-C01KC 吉野彰（旭化成（株））“Latest trends of Lithium Ion Battery Technology and Market” (9:50-10:10) 8a-C02OC N. Imanishi (Mie Univ., Japan) “High Performance Si/Disordered Carbon with CNFs Composites for Lithium Ion Batteries” (10:10-10:30) 8a-C03OC Z. Quan (Nagoya Inst. Of Tech., Japan) “Electrochemical property of LiCO2 thin films composed of Nanoparticles”	ブラズマ科学5 座長：近藤道雄（AIST） 【A会場】 (9:20-9:50) 基調講演 9a-A01KA J. G. Han (Sungkyunkwan Univ., Korea) “Novel Plasma Processes for Functional Thin Films for Flexible Electronics” (9:50-10:20) 基調講演 9a-A02KA J. Vleck (Univ. of West Bohemia, Czech Republic) “Pulsed Magnetron Deposition of High-Temperature Si-B-C-N Films” (10:20-10:40) 9a-A03OA (10360) Kusumandari (Nagoya Univ., Japan) “Characterization of Damages of Al2O3/Ge Gate Stacks Structure Induced with Light Radiation during Plasma Nitridation” (10:40-11:00) 9a-A04OA (10134) Y. H. Kwon (Sungkyunkwan Univ., Korea) “Electrical properties of the nickel oxide correlated with point defects induces by growth temperature and gas atmosphere”	座長：S. Arulkumaran (Nanyang Techn. Univ., Singapore) 【B会場】 (9:20-9:50) 基調講演 9a-B01KB F. Scholz (Ulm Univ., Germany) “Semipolar GaInN Quantum Well Structures on Large Area Substrates” (9:50-10:10) 9a-B02OB (10204) Chia-Feng Lin National Chung Hsing University, Taiwan) “Micro-Square-Array InGaN-based Light-Emitting Diode with an insulated Ga2O3 layer through a photoelectrochemical process” (10:10-10:30) 9a-B03OB (10399) T. Araki (Ritsumeikan Univ., Japan) “TEM Study on Microstructure of Mg-doped InN Grown by RF-MBE Using DERI Method”	ナノ材料5 座長：三浦永理（名古屋工業大学） 【C会場】 (9:20-9:50) 基調講演 9a-C01KC 水内基（地独）大阪市立工業研究所）“Densification and Development of Synthesis Route for Enhancing Performance of Heat Dissipative Metal Matrix Composites in Continuous Solid-Liquid Co-Existent State” (9:50-10:10) 9a-C02OC (10329) H. Sato (Nagoya Inst. of Tech., Japan) “Effects of Dispersoids on Wear Behavior of Cu-based Composite Containing SiO2 Particles” (10:10-10:30)招待講演 9a-C03IC Y. Ishikawa (JFCC, Japan) “White Photoluminescence from Carbon Incorporated Silica”		
	(10:10-10:30) 休憩	(10:40-10:50) 休憩	(10:30-10:50) 休憩	(10:30-10:50) 休憩					
	基幹・東海広域クラスター講演 座長：野田正治（AIST） 【A会場】 (10:30-11:00) 基幹講演 7a-A02SK John Robertson (Cambridge Univ., UK) “Applications of Carbon Nanotubes Grown by Chemical Vapor Deposition” (11:00-11:20) 東海広域ナノテクものづくりクラスター講演 7a-A03C 堀 勝（名古屋大学）“Fundamental Research and Global Innovation on Plasma Nanoprocessing” (11:20-11:35) 東海広域ナノテクものづくりクラスター講演 7a-A04C 江川 孝志（名古屋工業大学）“Study on AlGaIn/GaN HEMT Grown on Si Substrate” (11:35-11:50) 東海広域ナノテクものづくりクラスター講演 7a-A05C 高井 治（名古屋大学）“Material Development by Means of Solution Plasma” (11:50-12:05) 東海広域ナノテクものづくりクラスター講演 7a-A06C 渡辺 義見（名古屋工業大学）“Drilling of Carbon Fiber Reinforced Plastic by Gyro-Driven Metal-bonded Grinding Wheel”	II 座長：M. J. Goeckner (Univ. of Texas, Dallas, USA) 【A会場】 (10:50-11:20) 基調講演 8a-A04KA F. Laermer (Robert Bosch GmbH, Germany) “BOSCH-DRIE: Impact on MEMS and Applications” (11:20-11:40) 8a-A05OA (10125) J. Ladroue (GREMI-STMicroelectronics, France) “Deep Gallium Nitride Etching: Ways to Avoid Etching Defects” (11:40-12:00) 8a-A06OA X. Li (Univ. of Glasgow, Scotland) “A Low Damage Etching Process of Sub-100 nm Platinum Gate Line for Bi-V MOSFET Fabrication and the Optical Emission Spectrometry of the Inductively Coupled Plasma of SFB/C4F8”	座長：井上薫（パナソニック）（株） 【B会場】 (10:50-11:20) 基調講演 8a-B04KB A. Krost (Otto von Guericke Univ. Magdeburg, Germany) “Present and Future of GaN-on-Si” (11:20-11:40)招待講演 8a-B05IB S. Arulkumaran (Nanyang Tech. Univ., Singapore) “High Off-state Breakdown Characteristics of AlGaIn/GaN HEMTs on 4-inch Si” (11:40-12:00) 8a-B06OB (10338) Y. Liu (Sun Yat-sen University, China) “Normally-off AlGaIn/GaN HFETs on Si (111) Substrate Fabricated by Selective Area Growth Technique”	ナノ材料4 座長：猪股智彦（名古屋工業大学） 【C会場】 (10:50-11:20) 基調講演 8a-C04KC H-C. Zhou (Texas A&M Univ., USA) “Super Hard Diamond-like Carbon Films: A State-of-the-Art” (11:20-11:40) 招待講演 8a-C05IC (10418) S. Furukawa (Kyoto Univ., Japan) “An Entangled Porous Framework As a Luminescent Sensor” (11:40-12:00) 招待講演 8a-C06IC A. Takeda (Gifu Univ., Japan) “Nano Porous Polymer Film and Fiber by Craze Processing”	ブラズマ科学6 座長：近藤道雄（AIST） 【A会場】 (11:10-11:40) 基調講演 9a-B05OB (10098) Y. Tomita (LayTec GmbH, Germany) “In-situ Measurement of Wafer Bow and GaN Surface Temperature –how MOCVD Process Parameters Influence the Uniformity of LED” (11:40-12:00) 9a-B06OB (10348) T. Kawamura (Mie Univ., Japan) “Molecular Dynamics Simulation of Solution Growth of GaN”	座長：Scholz (Ulm Univ., Germany) 【B会場】 (11:20-11:40) 9a-B05OB (10098) Y. Tomita (LayTec GmbH, Germany) “In-situ Measurement of Wafer Bow and GaN Surface Temperature –how MOCVD Process Parameters Influence the Uniformity of LED” (11:40-12:00) 9a-B06OB (10348) T. Kawamura (Mie Univ., Japan) “Molecular Dynamics Simulation of Solution Growth of GaN”	ナノ材料6 座長：滝川浩史（豊橋技術科学大学） 【C会場】 (11:20-11:40) 9a-C05OC (10410) H. Kondo (Nagoya Univ., Japan) “Study on Crystallographic Features of Carbon Nanowalls using Synchrotron X-ray” (11:40-12:00) 9a-C06OC (10280) T. Kato (Tohoku Univ., Japan) “Novel Approach for Detailed Structure Control of Single-Walled Carbon Nanotubes based on Time-Programmed Plasma CVD”		
	(12:05-13:00) 昼食	(12:00-13:00) 昼食	(12:00-13:00) 昼食	(12:00-13:00) 昼食					
	(13:00-14:30)ポスターセッション1	(13:00-14:30)ポスターセッション3	(13:00-14:30)ポスターセッション4	(13:00-14:30)ポスターセッション4					
	ブラズマ科学1 座長：D. Graves(Univ. of California, Berkeley, USA) 【A会場】 (14:30-15:00) 基調講演 7p-B01KA U. Czarnetzki (Ruhr Univ. Bochum, Germany) “Determination of Electron Densities by Diode Laser Absorption Spectroscopy” (15:00-15:30) 基調講演 7p-A02KA J. P. Booth (CNRS, France) “Seeing Inside Plasma Etch Reactors: From Diagnostics to Sensors for Control” (15:30-15:50) 7p-A03OA (10072) I. Liang (Chubu Univ., Japan) “Electron Density Measurement by Novel Frequency Shift Probe” (15:50-16:10) 7p-A04OA (10139) N. Sumi (Nagoya Univ., Japan) “Real-time Electron-spin-resonance Measurement of Plasma Induced Surface Interactions”	座長：N. Grandjean(EPFL, Switzerland) 【B会場】 (14:30-15:00) 基調講演 7p-B01KB B. Daudin (CEA Grenoble, France) “Individually Dispersed Nanoparticles by Gas Evaporation and their Applications” (15:00-15:20) 7p-B02OB (10261) Y. Kawai (Nagoya Univ., Japan) “Realization of Excellent Crystalline Quality of AlGaIn Epilayer Grown on AlN Template by Plasma-assisted Molecular Beam Epitaxy” (15:20-15:40) 7p-B03OB (10227) T. Ohachi (Doshisha Univ., Japan) “Parallel Mesh Electrode to Monitor Nitrogen Atoms for Growth of III Nitride Semiconductors by PA-MBE” (15:40-16:00) 7p-B04OB (10057) J. Birch (Linköping Univ., Sweden) “Ion-assisted Magnetron Sputter Epitaxy of Group III-nitrides”	ナノ材料1 座長：日原岳彦（名古屋工業大学） 【C会場】 (14:30-15:00) 基調講演 7p-C01KC 小田正明（（株）アルバック） “Properties of InGaIn/GaN Nanowires” (15:00-15:20) 7p-C02OC R. Boswell (Australian National Univ., Australia) “Low Temperature Sputtering of Nanocrystalline N-doped TiO2 Thin Films with Ar/O2/N2 Helicon Plasma” (15:20-15:40) 7p-C03OC (10379) S. Yooen (Mie Univ., Japan) “Pulse Plasma CVD on the Growth of Nanorod” (15:40-16:00) 7p-C04OC (10272) S. Machmudah (Kumamoto Univ., Japan) “Gold and Silver Nanoparticles Produced by Pulsed Laser Ablation in Supercritical CO2”	代座長：東脇正高（（独）情報通信研究機構 新世代座） 【A会場】 (14:30-15:00) 基調講演 8p-A01KB A. Khan (Univ. of South Carolina, USA) “Recent Progress of Nitride Semiconductor Devices and the Role of Plasma Science and Technology” (15:00-15:30) 基調講演 8p-A02KB D. Alquier (Université de Tours, France) “Recent Progresses in GaN Power Rectifier” (15:30-16:00) 基調講演 8p-A03KB 上田 大助(パナソニック(株)) “Renovating Power Electronics by III-Nitride Devices” (16:00-16:30) 基調講演 8p-A04KB 天野 浩(名古屋大学) “Plasma Assisted Molecular Beam Epitaxial Growth of Thick InGaIn Films and InGaIn Nanorods for Future Light Source”	座長：浜田恵美子（名古屋工業大学） 【A会場】 (14:30-15:00) 基調講演 有本 建男（（独）科学技術振興機構） “Japan’s New Science and Innovation Policy –Beyond the Boundaries for Innovation–” (15:00-15:05) 基調講演 C. Mantel (Selantek, Inc., USA) ※Mantel氏は都合により来日出来なくなりました。 “Semiconductor Manufacturing –Future Technology–” （（財）科学技術交流財団 吉村 克信より資料説明） (15:05-15:35) 基調講演 W. Vandervorst (IMEC, Belgium) “Imec, a Research Center with Flexible Business Opportunities Balancing between Fundamental Research, Advanced Technology and Innovative Applications ” (15:35-16:05) 基調講演 泉谷 渉（（株）産業タイムズ社） “Current Situation and Direction for Development on Semiconductor Industry in Asia/Japan” (16:05-16:30) 基調講演 堀 勝(名古屋大学) “Foundation of Global Innovation Research Center for Advanced Plasma Science and Technology”	(16:30-16:50) 休憩	(16:30-16:40) 休憩		
	ブラズマ科学2 座長：U. Czarnetzki(Ruhr Univ. Bochum, Germany) 【A会場】 (16:20-16:50) 基調講演 7p-A05KA D. Graves (Univ. of California, Berkeley, USA) “Plasma-Surface Interactions at the Nanometer Scale” (16:50-17:10)招待講演 7p-A06IA S-Y. Kang (Tokyo Electron Ltd. Technology Development Center) (17:10-17:30)招待講演 7p-A07IA (拝受) Y. Tanaka(Kanazawa Univ., Japan) “Numerical Thermofluid Model of High-Power High-Pressure ICPs with Molecular gases using Reaction Kinetics”	座長：F. Ponce (Arizona State Univ., USA) 【B会場】 (16:20-16:50) 基調講演 7p-B05KB N. Grandjean (EPFL, Switzerland) “AlIn Alloy for Electronic and Optoelectronic Applications” (16:50-17:10) 7p-B06OB (10028) W. Y. Weng (National Cheng Kung Univ., Taiwan) “High Responsivity GaN Nanowire-based UV Photodetectors” (17:10-17:30) 7p-B07OB(10182) H. S. Jeon (Korea Maritime Univ., Korea) “UV LED with High Quality Epilayer grown by HVPE”	ナノ材料2 座長：牧原 克典（名古屋工業大学） 【C会場】 (16:20-16:50) 基調講演 7p-C05KC 滝川 浩史（豊橋技術科学大学） “Super Hard Diamond-like Carbon Films: A State-of-the-Art” (16:50-17:10) 7p-C06OC J-H. Jin (Korea Univ., Korea) “Effects of Plasma Surface Functionalization on Biosensing Characteristics of A Fully-Integrated CNT-based Electrode System on Glass Substrate” (17:10-17:30) 7p-C07OC (10301) C. Geffers (RWTH Aachen Univ., Germany) “Nanophase Hardfaced Coatings”	座長：岩崎誠（名古屋工業大学） 【A会場】 (16:50-18:10) パネルディスカッション 先進プラズマ技術の窒化物半導体への応用II Application of Advanced Plasma Technology for Nitride Semiconductors II Succeeding to ISPlasma2010, the role of plasma science and technology for applications to nitride semiconductors such as; plasma processing for device fabrication and nitrogen radical source for crystal growth and others will be discussed. ＜モデレーター＞ 名西 博之（立命館大学, Seoul National Univ., Korea) ＜パネリスト＞ D. Alquier (Université de Tours, France) 天野浩（名古屋大学） B. Daudin (CEA Grenoble, France) N. Grandjean (EPFL, Switzerland) 加納浩之（NUエコ・エンジニアリング(株)） A. Khan (Univ. of South Carolina, USA) E. Monroy (CEA Grenoble, France) 徳田豊（愛知工業大学） 上殿明良（筑波大学） 上田大助（パナソニック(株)）	座長：豊田浩孝（名古屋工業大学） 【A会場】 (16:40-18:00) パネルディスカッション オープンイノベーションを目指した先進プラズマナノ科学国際拠点の形成 ＜モデレーター＞ 小竹 暢隆（名古屋工業大学） ＜パネリスト＞ 有本 建男（（独）科学技術振興機構） 堀 勝(名古屋大学） 泉谷 渉（（株）産業タイムズ社） 間所 陽一郎（愛知県産業労働部） W. Vandervorst (IMEC, Belgium)	(18:00-19:30) ウェルカムパーティ（名工大カフェサラ）	(17:30-19:00)ポスターセッション2	(18:10-18:30) 移動 (18:30-20:00) パンケット(サッポロライオン名古屋ビール園浩養園)	(18:00) 閉会 ※予定されていた以下の講演は変更となりました。3月9日(水) 10:50-11:20 ナノ材料6 カーボン材料基調講演: M. Meyyappan (NASA Ames Research Center, USA) “Plasma Nanotechnology: Past, Present, and the Future”

同時通訳あり

参加費無料